





	<h2 style="color: red;">FQD30N06TF</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD30N06TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD30N06TF.pdf 2.FQD30N06TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32368 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD30N06TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32368 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	22.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 11.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	945pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD30N06TF ist neu im Original, Suche FQD30N06TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD30N06TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD30N06TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD30P06 FAIRCHILD FQD30P06 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD30N06TF_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p>	 <p>FQD30N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>
 <p>FQD30N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p>FQD30N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p>FQD30N06TF_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p>	 <p>FQD30N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD2N60C	↔ FQD2N60CTF	⇒ FQD2N60CTF	D FQD2N60CTF-NL	↔ FQD2N60CTF_F080
⊣ FQD2N60CTF_F080	⊗ FQD2N60CTM	D FQD2N60CTM	⇒ FQD2N60TM	↔ FQD2N60TM
⊗ FQD2N65C	⊣ FQD2N80TM	⊗ FQD2N80TM	↔ FQD2N80TM-NL	↔ FQD2N90TF
D FQD2N90TF	⊗ FQD2P25TF	⊣ FQD2P25TM	⊗ FQD30N06	↔ FQD30N06L
⇒ FQD30N06LTF	↔ FQD30N06LTF	⊗ FQD30N06LTM	⊣ FQD30N06LTM	↔ FQD30N06TF
↔ FQD30N06TF_F080	⇒ FQD30N06TF_F080	D FQD30N06TM	⊗ FQD30N06TM	⊣ FQD30P06
⊗ FQD3N25T	D FQD3N30TF	⇒ FQD3N30TF	↔ FQD3N30TM	↔ FQD3N30TM
⊣ FQD3N40TM	⊗ FQD3N40TM	↔ FQD3N50C	⇒ FQD3N50C/CS	↔ FQD3N50CTF
⊗ FQD3N50CTF	⊣ FQD3N50CTM	⊗ FQD3N50CTM	D FQD3N60C	↔ FQD3N60CS
↔ FQD3N60CTF	⊗ FQD3N60CTM	⊣ FQD3N60CTM_WS	⊗ FQD3N60TF	↔ FQD3N60TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited